

第10回SPring-8グリーンサスティナブルケミストリー研究会/ 第64回SPring-8先端利用技術ワークショップ 「環境・エネルギー関連触媒および燃料電池開発の最前線」 表面プロトニクスを活かした電場中での低温触媒反応の学理と応用 2021年12月3日



2021/3 RSCイギリス王立化学会 フェロー 2020/4 文部科学大臣表彰 科学技術賞 受賞 2019/1 日本化学会 学術賞受賞 早大の次代中核研究者に選定

産業構造審議会グリーンイノベ部会委員・WG グリーンイノベ戦略会議議員・WG座長 JSTフェロー Elsevier "Fuel"誌 編集責任者 JSTさきがけ「反応制御」領域総括 NEDO未踏チャレンジ2050 領域総括 国際天然ガス転換会議 日本代表 日本学術会議 特任連携会員

- ▶ 非在来型触媒プロセスとしての表面プロトニクス
 - ▶ 電場印加表面プロトニクスによる低温触媒プロセス
 - > 二酸化炭素再資源化
 - ▶ アンモニア合成
 - ▶ 電場を印加した低温排気ガス浄化触媒プロセス



- ▶ 非在来型触媒プロセスとしての表面プロトニクス
 - ▶ 電場印加表面プロトニクスによる低温触媒プロセス
 - > 二酸化炭素再資源化
 - > アンモニア合成
 - ▶ 電場を印加した低温排気ガス浄化触媒プロセス



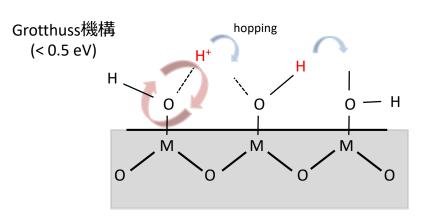
表面プロトニクス … 固体電解質表面でのプロトン伝導

- ○含水系の表面プロトニクス
- ✓ 固体電解質表面の(i)酸塩基特性と(ii)欠陥化学由来のプロトンが、吸着水を介して輸送される

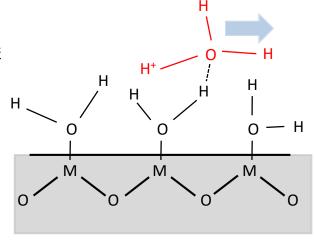
(i)
$$M-OH + M-OH = M-O^- + M-OH_2^+$$

(ii)
$$H_2O(g) + O_0^x + V_0^x = 2OH_0^x$$

マプロトンの輸送機構はGrotthuss機構とVehicle機構



Vehicle機構 (< 1.0 eV)



- ○非含水系の表面プロトニクス
- レ供給中のH₂がH⁺とe⁻、場合によってはヒドリド(H⁻)を与え、プロトン伝導が発現すると考えられる。

$$H_2(g) + V_0^{"} = H_0^{"} + H_1^{"}$$

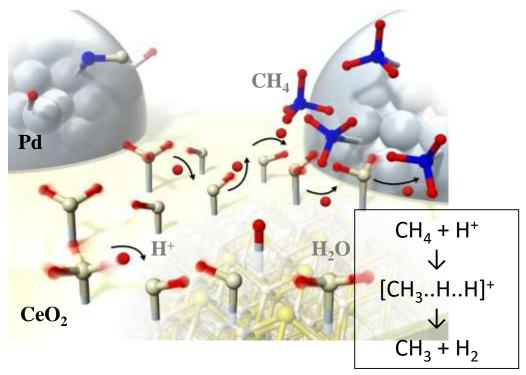
1/2 $H_2(g) + V_0^{"} = H_0^{"} + h_1^{"}$

- ✓半導体性を有する担持金属触媒へのDC電場印加
- ⇒水素源由来のプロトンが触媒表面を拡散 [表面プロトニクスの発現]
- ✓表面プロトニクス由来のプロトン
- ⇒低温で安定な化学原料を活性化 「表面プロトニクスによる不均一触媒反応の促進]

表面プロトニクスが 新たな触媒反応メカニズムを創り出す



表面プロトニクスは 低温でのメタン解離吸着を促進する

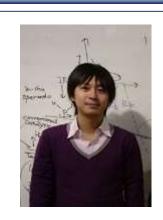


電場印加により表面プロトニクスが誘起され、 不活性なメタンが100度台で速やかに反応し高い収率が得られる



電場を活かした低温触媒反応

▶ペロブスカイト型酸化物やセリウム酸化物などの 半導体性を有する酸化物を担体に用い、金属を担持して 外部から直流の電場を印加



Ph.D. Ryo Manabe@早稲田

- ▶ 触媒表面の吸着種を介して、水素イオンの移動 (プロトンホッピング)を促進し、反応が従来と 異なるメカニズムで低温でも高効率に進む

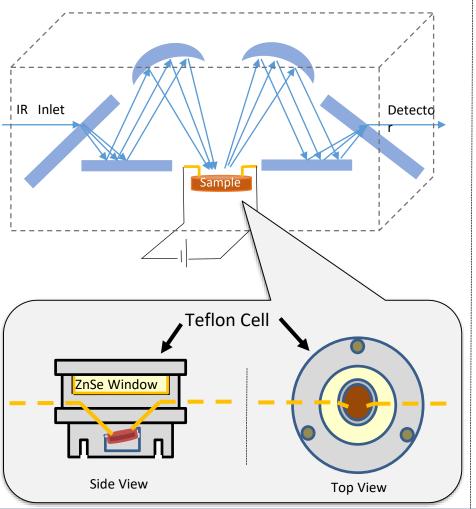
電場を活かした低温触媒反応

- ▶ 水素同位体を用いた同位体速度解析→反応メカニズムが C-H-H+を中間体とする不可逆性を有するパスとなる
- ➤ アレニウスプロットから見かけ活性化エネルギーが電場印加に伴う プロトンホッピングにより大幅に低下(107 kJ/mol→38 kJ/mol)
- ▶ operando赤外分光から電場中ではGrotthuss機構による プロトン伝導由来のスペクトルが観察
- ▶ 交流インピーダンス法による表面イオン伝導観察により300度以下では 表面プロトニクスが支配的となる
- プラズマとは異なり消費電力が小さく、オンデマンドで低温で駆動でき、電解に比べて高効率



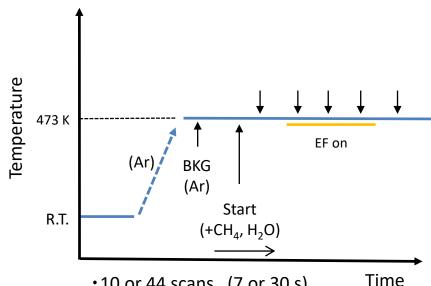
Operando-IR測定

光学系(拡散反射法)



測定条件

- ・スペクトル測定温度: 473 K, 673 K
- ·触媒:1 wt% Pd/CeO₂ (355-500 µmに整粒済、100 mg)
- ・ガス供給: 65 SCCM, CH₄: H₂O: Ar = 1:2:62
- •電流: 5 mA
- ・出口ガスをリアルタイム分析



- •10 or 44 scans (7 or 30 s)
- •At resolution of 4.0 cm⁻¹
- Aperture 7.1 mm

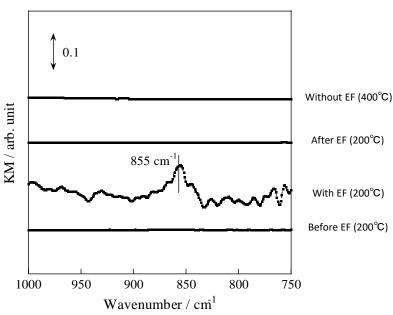
R. Manabe et al. Sci. Rep., 6, 38007 (2016).

S. Okada et al. Catal. Today (2018)

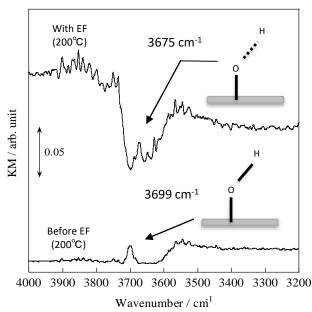


operando IR spectra

Low wavenumber region



Adsorbed water



With the electric field application,

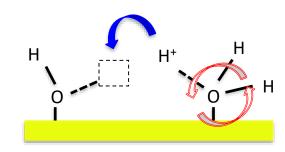
- The peak assigned to water rotation at 855 cm⁻¹ was observed.
- ➤ The red-shift (24 cm⁻¹) of O-H vibration peak was observed.

O-H bond energy was weakened approximately 25 kJ mol⁻¹ (O-H = 1.02 \mathring{A})

⇒ プロトンが表面O-Hを介してホッピング

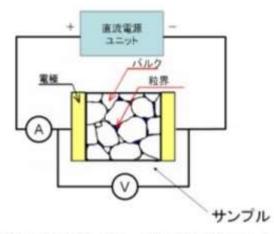
表面プロトニクスがIRにより観察

Proton transfer via Grotthuss mechanism





交流インピーダンス法について



直流法によるセラミック図1 イオン導電体の測定イメージ



図2. セラミックスイオン導電体で発生する様々な抵抗成分

(交流インピーダンス測定、中山将伸教授HPより引用)

(固体) 電解質における各部位の伝導率測定

- ✓材料に固有なバルク抵抗に加え、左図のような粒界抵抗・電極接点付 近の界面抵抗が存在。
- ⇒ 抵抗の分離が必要
- ✓外部電場に対する各抵抗部位のキャリアが異なる応答時間を示す
- ⇒交流の周波数を掃引することで、抵抗の分離が可能
- ✓ 材料の伝導率の正確な評価には単結晶試料を用いることが理想的だが、 大きな空孔が存在しない高密度なサンプルで代替
- ⇒ 多結晶の焼結体を用いて電解質内部のバルク・粒界抵抗を評価

交流インピーダンス法で表面プロトニクスを評価・抽出

お問い合わせ ysekine@waseda.jp



交流インピーダンス試験

✓ Sample: CeO₂ (JRC-CEO-1)

✓ Relative density: 58 %

✓ Electrode: Pt ink (both sides)

✓ Flow:

 $dry \rightarrow Ar flow$

wet → Ar bubbling system

 $(0.026 \le P_{H2O} \le 0.2 \text{ atm})$

✓ Temperature: 125 – 500 °C

In ProboStat measurement cell (NorECs),

with a standard 2-electrode-4-wire set up (shown in right side) connected to a Novocontrol alpha-A impedance spectrometer with a ZG4 interface

 \checkmark Frequency range : 10^{-3} ~ 10^{7} Hz

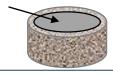
✓ Amplitude : 0.1V RMS

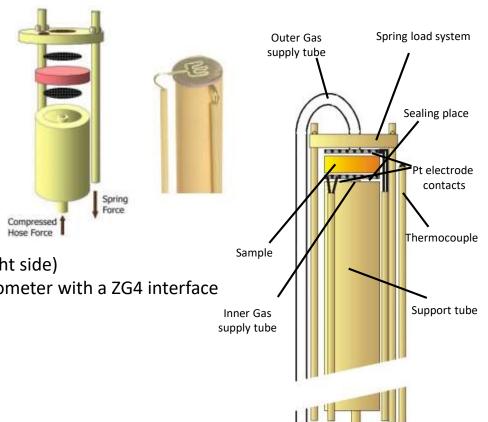
Analysis

✓ ZVIEW equivalent circuit fitting software (version 3.5a, Scribner Associate Inc.)

$$S = 25\pi \text{ mm}^2$$

$$\sigma = \frac{L}{S} \frac{1}{R}$$



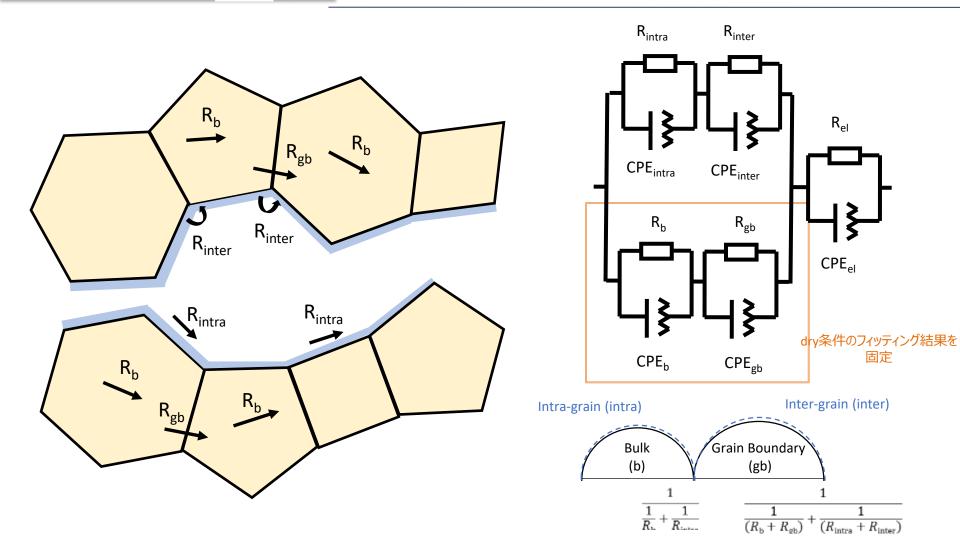




Prof. Norby@Oslo U.とのコラボ



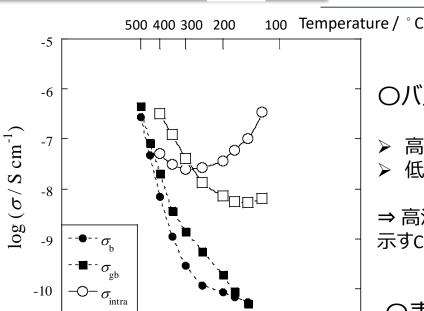




お問い合わせ ysekine@waseda.jp



各伝導率の温度依存性



Dry: Ar Wet: $P_{H2O} = 0.026$ atm

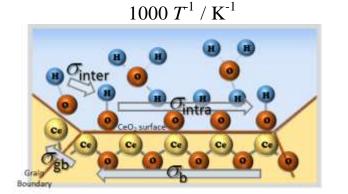
〇バルク内部(gおよびgb)の伝導率の挙動

- 高温(>300 ℃)における見かけ活性化エネルギーは1 eV以上
- 低温(<300 ℃)における見かけ活性化エネルギーは0.4 eV未満
- ⇒ 高温で酸素イオン伝導、低温で電子伝導の混合伝導性を 示すCeO。の物性を反映

○表面(intraおよびinter)の伝導率の挙動

- ▶ ある温度(300 or 150 °C)より低温で伝導率が上昇する特異な 挙動
- ⇒ 電解質表面(ポーラスなCeO₂, TiO₂, YSZ)に吸着する水の量が低 温で増加、吸着水由来のプロトン伝導

吸着水由来の表面プロトニクスを 抽出することに成功



1.5

-11

0.5

本日の話題のポイント

- ▶ 非在来型触媒プロセスとしての表面プロトニクス
 - ▶ 電場印加表面プロトニクスによる低温触媒プロセス
 - > 二酸化炭素再資源化
 - > アンモニア合成
 - ▶ 電場を印加した低温排気ガス浄化触媒プロセス

お問い合わせ ysekine@waseda.jp



低温でCO゚を資源化

セリウム酸化物とルテニウ

プロトニクスによる二酸化炭素資源化

早大グループが手法発見 効率よくCOやメタンに変換

NHK朝の全国ニュース

週刊プレイボーイ

低

で化学工業日報

2020/2/3

トップ10イノベーション

トップ10イノベーションとは

「トップ10イノベーション」とは、エネルギーおよび気候変動緩和に資する最近のイノベーションの中から特に優れた事例を選出するイベントで、エネルギー・環境分野における社会変革への貢献が期待される技術開発・普及の最新事情が紹介されます。分野別のイノベーションの現状と動向を理解し、今後一層の取組を必要とする分野を明らかにする上で有益なイベントです。

ICEF 2020 選出結果 (10.158 KB) 54

カテゴリ	タイトル	組織・団体 Washington State University and Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) 早稲田大学		
R&D 2050年までの禁事子院	ナトリウムイオン雲池の頭祭			
R&D 2050年までの普及予測	低温での二酸化炭素のメタン化技術の開発			
R&D 2050年までの普及予測	高効率な太陽光エイルキーによる水素製造プロセス	Australian National University		
R&D 2050年までの普及予測	太陽電池の効率改善技術 (光子1個で電子2個の生成)	Massachusetts Institute of Technology (MIT)		
社会実装 2030年までの普及予測	世界最高の発電効率を持つ家庭用燃料電池の発売	大阪ガス株式会社、アイシン精機株式会社、京セラ株式会 社、株式会社ノーリツ、パーパス株式会社、リンナイ株式 会社		

各種担持金属を用いた二酸化炭素転換

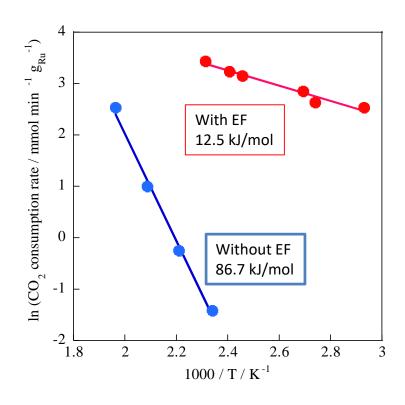
Table 3.1 Results of activity tests over various metal supported catalysts in the electric field

catalysts	Temp. / K	Power / W	CO ₂ conv.	CH₄ sel. /%	CO sel. /%
5wt% Ru/CeO ₂	416	0.84	17.4	96.4	3.6
0.5wt% Ru/CeO ₂	405	0.83	7.5	26.9	73.1
5wt% Co/CeO ₂	406	0.90	5.2	9.1	90.9
5wt% Cu/CeO₂	396	0.79	3.7	0.0	100.0
5wt% Ni/CeO ₂	428	0.94	11.2	63.6	36.4
5wt% Fe/CeO ₂	394	0.80	2.4	0.0	100.0
5wt% Mo/CeO ₂	377	0.51	0.0	-	-
5wt% Zn/CeO ₂	412	0.66	2.2	0.0	100.0
5wt% Ga/CeO ₂	447	1.49	6.9	0.0	100.0

CO₂:H₂:Ar = 1:4:5; 100 mL min⁻¹ total flow rate; 5.0 mA input current; 100 mg catalyst weight; 343 K furnace temperature

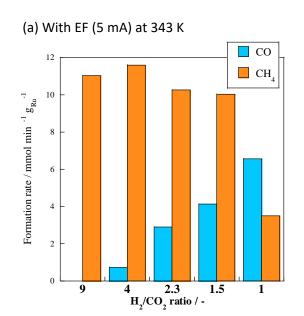


電場ありなしでのアレニウスプロット



電場印加に於いてはおおきく見かけ活性化エネルギーが低下 (熱の影響は別途評価済み)

電場有無による反応選択性の違い



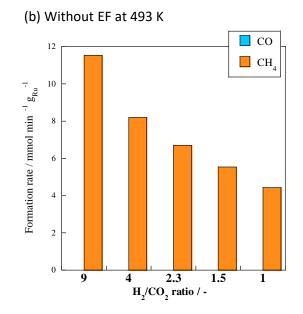
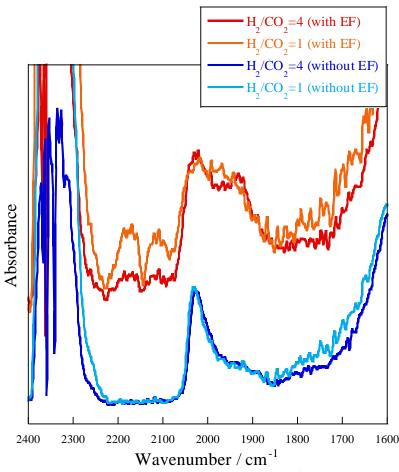


Figure 3.6 CH₄ and CO formation rates over Ru/CeO₂ catalyst under various H_2/CO_2 ratios (a) with EF at 343 K or (b) without EF at 493 K (CO₂:H₂:Ar = (1-5):(9-5):10; 200 mL min⁻¹ total flow rate; 100 mg catalyst weight).

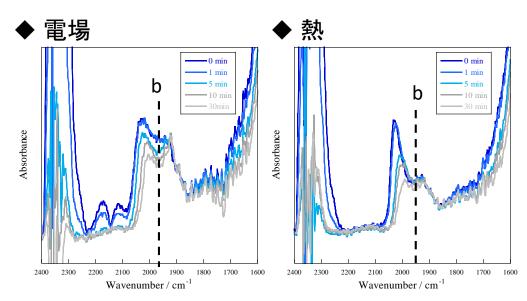
熱では水素二酸化炭素比率を変えてもサバティエしか起こらない触媒に対して電場を印加すると選択性が大きく変化



電場サバティエ反応における 熱と電場の赤外スペクトル比較



DRIFT spectra after reaction under different H_2/CO_2 ratios (1 or 4) over Ru/CeO_2 catalyst with EF (5 mA) at 343 K or without EF at 493 K (CO_2 : H_2 :Ar = 2:8:5 or 5:5:5; 15 mL min⁻¹ total flow rate).



bの吸収が電場でのみ減少 配位数の少ないRuサイトに 吸着したCOが水素化

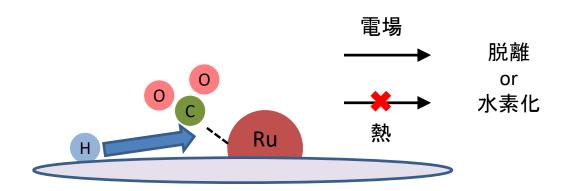
熱ではCOとして脱離できないので、配位数の少ないRu サイトは使えない

 $H_2/CO_2 = 1$ over Ru/CeO_2 catalyst (a) with EF (5 mA) at 343 K and (b) without EF at 493 K (CO_2 : H_3 :Ar = 5:5:5 or 0:5:10; 15 mL min⁻¹ total flow rate).

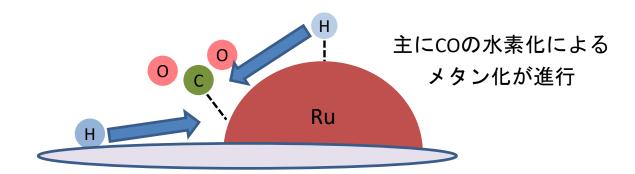


電場中のサバティエ反応モデルの推定

◆配位数の小さいRuサイト(単原子やRuとCeO₂の界面)



◆ 配位数の大きいRuサイト





二酸化炭素の再資源化のための材料



Carbon dioxide (CO₂) is a major cause of global warming and climate change



もかかわらず1時間1 来よりも低い反応温度 ト反応を行った結果、 ト反応を行った結果、

サケミカルルーピング反 の8 がイオンの移動速度が達 とっ 物イオンの移動速度が達 とっ や人酸化と選元を繰り返 せた と比較して低温でも酸化 性に を保り返 せた

光展が明符される。 大阪地域を目指す。銅 が表が少なく、研究 が表が少なく、研究 が表が少なく、研究 が表がのできれる。 CO²資源化触媒開発

Chemical Looping Reverse Water-Gas Shift (RWGS-CL)
using a novel structured Cu-In oxide

H2

Metal oxide (MO)

Reduced by solar-driven H2

H2O

MO + CO

Fuels

Chemicals

Structural characterization

- Reduced Cu structure supported by In₂O₃
- Cu-In alloy formation and reoxidation → Successful RWGS-CL

Novel metal oxide: Cu-In,O, Fast oxide ion migration into alloy bulk + preferential oxidation of alloyln₂O₃ interface → High CO₄ splitting rate

Kinetics

analysis

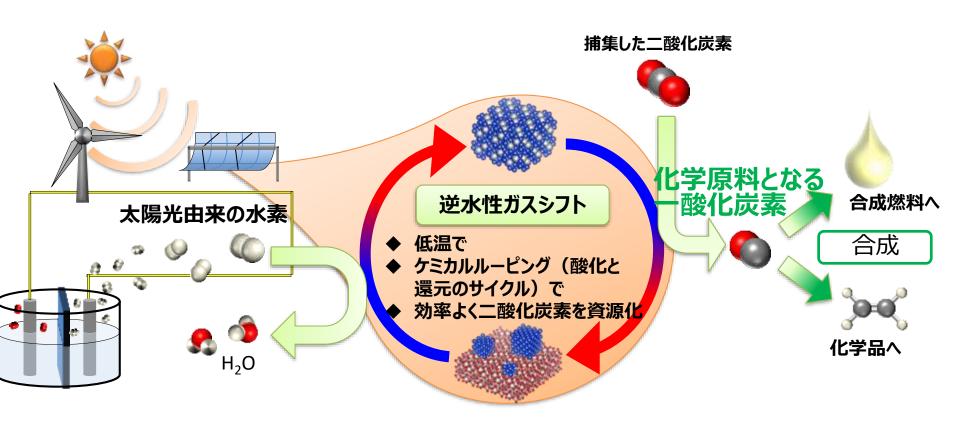
- Record CO₂ splitting
 - efficiency (>10 mmol h ¹g ¹)
- High reducability at lower temperatures (400-500°C)
- Simplified gas separation without byproducts

Novel Cu-In oxide oxide shows record-high CO₂ splitting rate at lower temperatures, opening up possibilities to reduce carbon emissions in the future

2021年1月13日化学工業日報

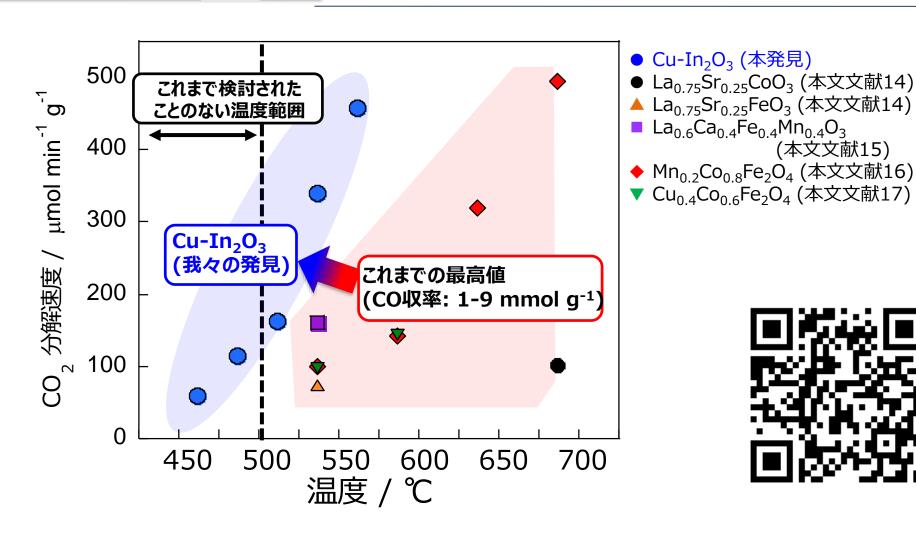


ループ型低温逆水性ガスシフト





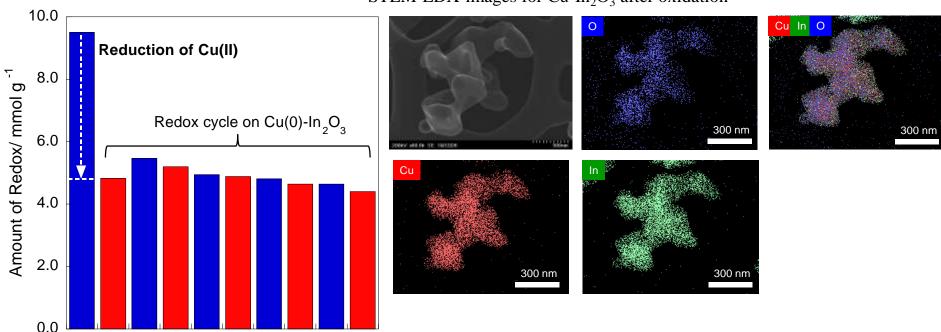
これまでより150度程度低温化



新しい材料と優れた特性

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5

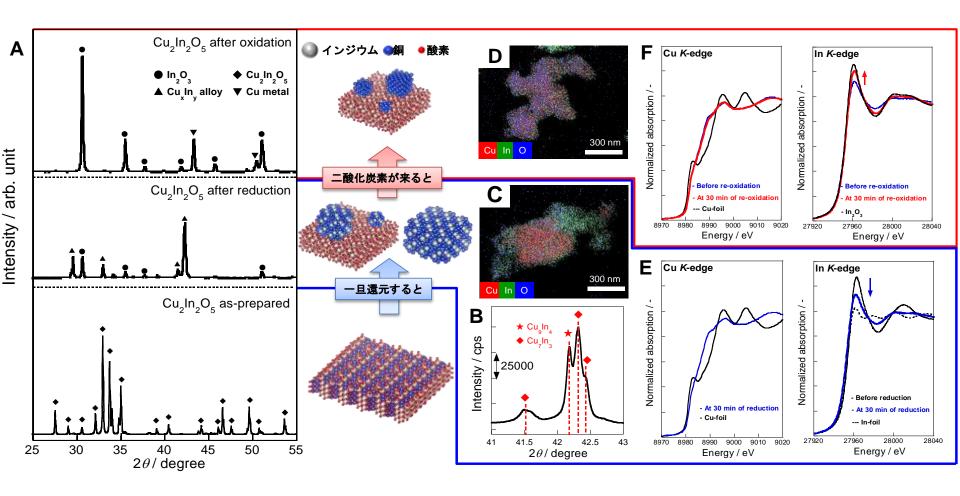
STEM-EDX images for Cu-In₂O₃ after oxidation



サイクル特性に優れ、CuとInが均等に分散し酸化物イオンの拡散が非常に速い



放射光での微細構造解析





- ▶ 非在来型触媒プロセスとしての表面プロトニクス
 - ▶ 電場印加表面プロトニクスによる低温触媒プロセス
 - > 二酸化炭素再資源化
 - ▶ アンモニア合成
 - ▶ 電場を印加した低温排気ガス浄化触媒プロセス

低温オンデマンドアンモニア合成

温での反応を可能にし 亜位を与えることで、低

レニウスの法則に従

化学反応は禁木的に

高温で反応速度が上

七二ア合成法を開発し 速やかに反応が進むアン

固体触媒に外部から

昇するが、

この反応は2

度が低い方が反応速度が

鼻する。今後の応用に

OO度C以下の領域で温

授らの研究グループは、 早稲田大学の関根泰教 早大 固体触媒に電荷作用 に同じ触媒を用いて反応 を行うと、300度C以

ンモニア 成

200

℃以下で反応進行

とき、低温だと触媒への

吸着が多くなり、そとに

ア合

有意に活性が落ちてい ものの、200度じでは 上では同様の活性を示す

反応のみ。今回の反応は 速度が向上するのは吸着 法則によると低温で反応 するというアレニウスの 化学反応は温度に依存

デマンド合成システムが 低エネルギーな小型オン 来の電力を用いることを グループは今後、 電荷が作用して反応速度 探索を進める。 ニズムで作用する物質の が上昇するという。研究 再生可能エネルギ

アンモニア高速合成

ほどで済む可能性があ 必要な温度と圧力がそれ

新技術を実際の製造製

モニア合成が可能になる

期待される。

お省エネルギーなアン

体性を有する固体触媒に

研究グループは、半導

学えると、200度CD

が部から6が一彩の電位を

触媒に電圧をかけるのが成する技術を開発した。 学肥料や医薬品の原料な 間で、迅速かつ低温で化 どに使うアンモニアを合 控心中非浩巳教授らの研 早稲田大学の関模響数 ムは日本触媒と共 異など 触媒に電圧かけ ロンチウムとジルコニウ ループはこの触媒に直流 触媒を利用する。研究グ あるルテニウムを置いた アメタル (希少金属) で ムの複合酸化物の上にレ 新技術では金属のスト

をめどに実用化を目指す 行戦。コスト面の検証や ニアが合成できることを 衝突し、効率的にアンモ を 反応をさらに促進できる し 部で利用されている。今し 部で利用されている。今 に 回は水素イオンの移動で モニアを合成していた。 ほどの高田をかけてアン ツシュ法」では窒素と水 従来の「ハーバー・ボ 度近い高温といり口気圧 素のガスからせ氏500 ルテニウムを利用して 助ケミカル・サイエンスジェクトの一端。 英科学 興機構 (JST)

た。200度で以下では、

かに進むことを発見し

の低温でも反応が速や

温度を下げていくと10

指す考えだ。 るコストなどが不明確な の改良を経て実用化を目 る。現状では導入にかか ため、実証試験や性能部 程で使うことができれ 研究成果は科学技術指 合成にかかるエネル を大幅に削減で含

日経 2017/6/19 化学工業日報2020/3/26

早大一日本触媒触媒に電力印加

低温で迅速合成

を担持した触媒に数づめ

OO度C程度の低温でも 男を印かすることでご

効率ようアンモニアが合

触媒プロセスを開発した 上兵 門で、低温かつ迅速 デンモニアを合成する 早稲田大学は日本勉媒 を印加する上低温でも効 とを発見、日本触媒が9 ンモニアを合成できるこ 気圧の条件で世界最高レ 率よく窒素と反応してア 名前い、欲しいときに欲

ベルの合成速度を実現し た。再生可能エネルギー が、ルテニウム(Ru)早大の研究グループ

できるようになるとい 成するプロセスが実用化 しいだけアンモニアを合

四で水素イオンがホッピ

反応を誘起する

のためのアンモニア製造 火力発電所における脱硝 た。原流電場中に触媒を 成できることを見いだし

噂くことによって腫媒表

での肥料製造プラント、 る可能性がある。遠隔地 合成プラントを実現でき 数百い規模のアンモニア ンデマンドで日星数十 物を併用することで、オ 電力を利用する水電解技

という。これまでの課題

解離の遅さを解決でき

た機管でのアンモニア燃

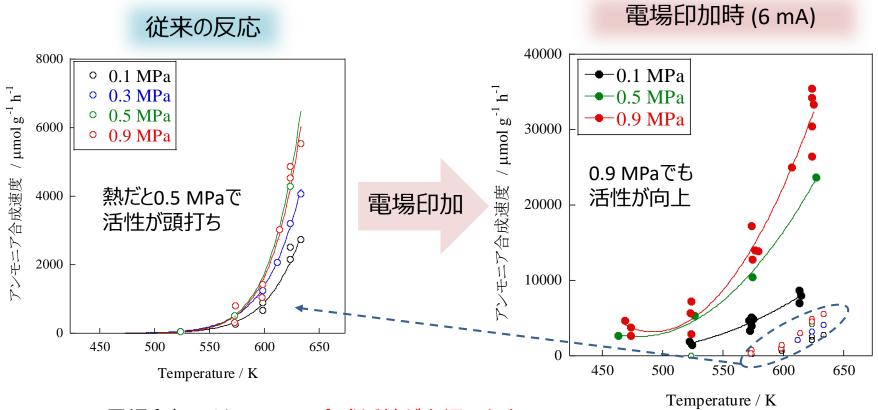
化学工業日報2017/6/9

設備、馬力発電を用し

- ▶ 再生可能エネルギー源を用いた高効率なアンモニア合成プロセスの確立
- ▶酸化物半導体を担体とした担持金属触媒に外部から電場を印加する電場触媒反応を用い、低い温度で進行しうる革新的アンモニア製造プロセスを実現
- ▶ 電場中での新規反応場におけるアンモニア合成について反応メカニズムを解析し高効率な触媒を開発
- ▶省エネルギー高効率プロセスを確立
- ➤ 実証を視野に入れたシステムを創出







- 電場印加によりアンモニア合成活性が大幅に向上
- 従来の反応では0.5 MPaで頭打ちになっていた活性が0.9 MPaでも向上
 →水素被毒の解消を示唆
 - R. Manabe et al., Chem. Sci, 2017, 8, 5434-5439.



In-situ IR測定による評価

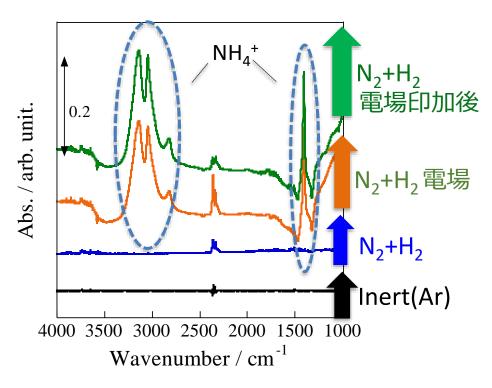
◆N₂+H₂供給(電場印加試験 @473 K)

担体:錯体重合法 活性種担持:逐次含浸法

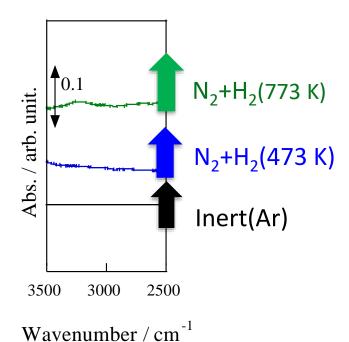
前駆体:RuCl₃·3H₂O CsNO₃

9.9 wt%Cs/5 wt%Ru/SrZrO₃

◆N2+H2供給(電場印加なし @473,773 K)



- ▶ 電場印加により新たなピークが出現
- NH₄+由来のピークであると考えられる



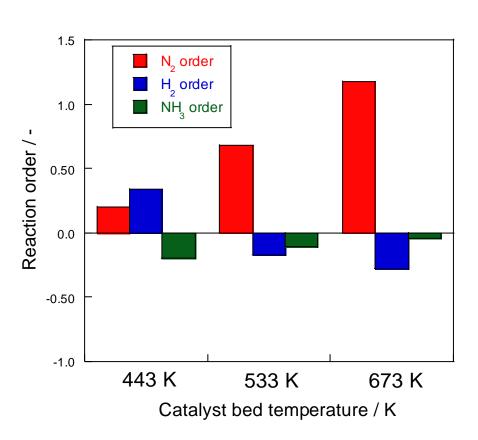
▶ NH₄+由来のピークは確認されなかった

目的:触媒層温度が反応メカニズムに及ぼす影響を検討

触媒:1wt%Ru/CeO₂ 触媒量:100 mg

前処理: N₂/H₂=60/180 SCCM, 450°C, 2h保持

印加電流值:6 mA

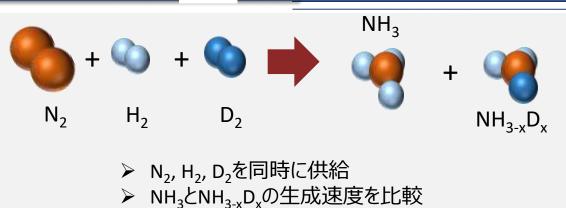


- 高温域(673 K)における反応次数は従来の アンモニア合成の傾向と合致
 - ①N₂次数が1に近い値を示す→N₂解離が律速段階であるため
 - ②H₂次数が負の値を示す →HがRuの空きサイトを埋めて被毒するため
- ▶ 触媒層温度の変化に伴って反応次数も大きく変化 ①温度の低下に伴いN,次数が減少
 - →低温域においてN₂の解離が促進されている
 - ②温度の低下に伴いH₂次数は正に変化 →低温域におけるN₂解離の促進にH₂が寄与

お問い合わせ ysekine@waseda.jp

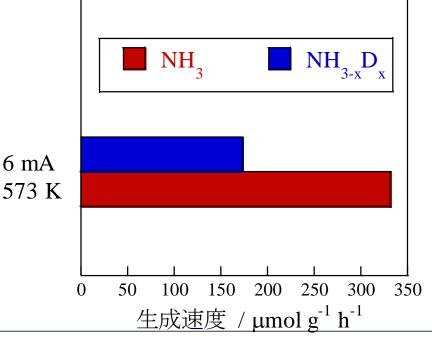
水素化過程におけるD。同位体効果





- ·触媒: Cs/Ru/SZO
- ·印加電流值:6 mA
- ·印加電圧值:約0.2kV
- ・供給ガス: N₂: H₂: D₂ = 1:1.5:1.5

(Total 60 SCCM)



- ➤ (NH₃生成速度) > (NH_{3-x}D_xの生成速度)
 - 水素化過程には一次同位体効果が発現
 - 水素化過程は速度論領域にある





➤ H₂由来の種がN₂解離に直接関与している可能性

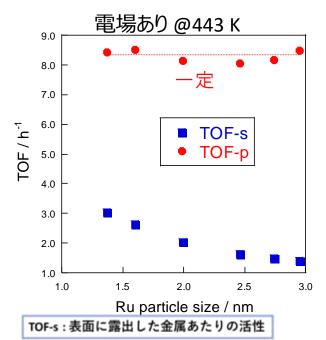
目的:電場印加時の活性点を明らかにする

触媒:0.5-5 wt%Ru/CeO₂

触媒量:100 mg

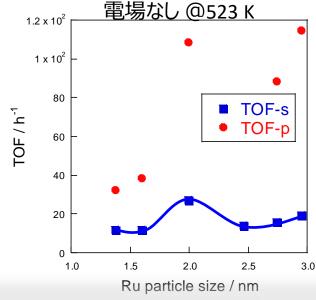
前処理: N₂/H₂=60/180 SCCM, 450°C, 2h保持

印加電流值:6 mA



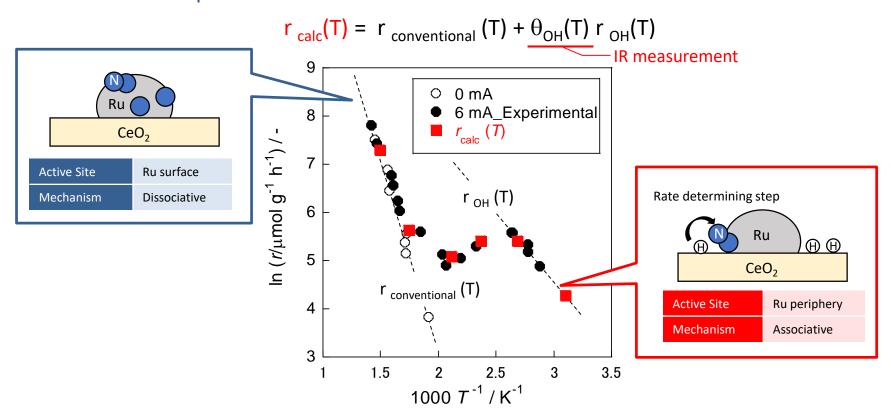


TOF-p: 担持金属と担体の界面に存在する金属あたりの活性



- 電場を印加していない際はTOF-sが2 nm付近で 最大値を示した
 - →Ru表面に存在するステップサイトの割合が 最大になることに起因
 - →従来のRu系触媒と同様の傾向3)
- 電場を印加した場合はTOF-pがRu粒子径に関係なく 一定の値を示した
 - →電場印加時はRu-担体界面で反応が進行

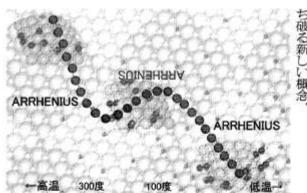
■ Reaction rate equation in the electric field



- r_{calc} was calculated using θ_{OH} (T) obtained by IR measurements
- r_{calc} showed great agreement with experimental values
- Novel reaction mechanism in the electric field is confirmed.



2020年3月26日報道各社



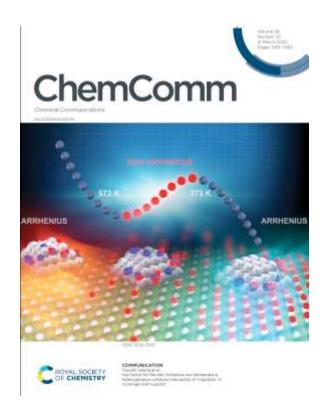
外部から電

38

スウェーデンのスヴァン 化学反応は高温にな

原因を探ってきた。 アレニウスの法則覆す

く進むことを発見し、その 化学品や水素運搬体とし

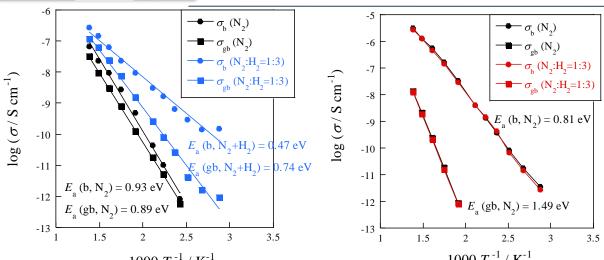


朝日新聞朝刊

K. Murakami, Y. Sekine et al., Chemical Communications, 56, 3365-3368, 2020.



表面伝導の評価手法の確立



Porousなサンプルでのみ水素雰囲気で伝導の変化が見られ、DによるKIEも見られた

温度 / K	Porous SrZrO ₃ sample			Dense SrZrO ₃ sample		
	$\sigma_{\rm H2}$ / S cm ⁻¹	$\sigma_{\! D2}$ / S cm ⁻¹	$\sigma_{\! m D2}/\sigma_{\! m H2}$ / -	$\sigma_{ m H2}$ / S cm ⁻¹	$\sigma_{\! m D2}$ / S cm ⁻¹	$\sigma_{\! m D2}/\sigma_{\! m H2}$ / -
 723	1.21×10^7	7.91×10^{8}	0.65	2.43×10^{6}	2.41×10^6	0.99
623	1.70×10^8	9.88×10^{9}	0.58	4.14×10^7	4.12×10^7	1.00
523	5.01×10^{10}	2.62×10^{10}	0.52	2.57×10^8	2.55×10^8	0.99
423	4.74×10^{11}	2.27×10^{11}	0.48	2.44×10^{10}	2.42×10^{10}	0.99

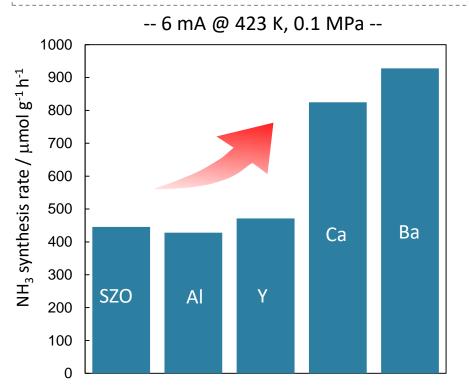
交流インピーダンス法と直流伝導評価、H/D交換を組み合わせることで、新たな表面プロトン伝導手法を確立(with Prof. Norby@Oslo Univ.)

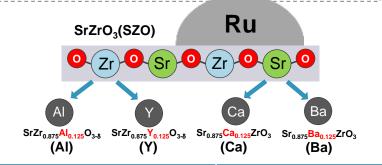


Increase of NH₃ synthesis rate by doping

Dopant effects on NH₃ synthesis rate in the electric field

Catalyst: 5wt%Ru/Support, Catalyst weight: 0.1 g (Thickness: 2 mm), Supplied gas: N₂: H₂ = 1:3 (Total 240 SCCM)



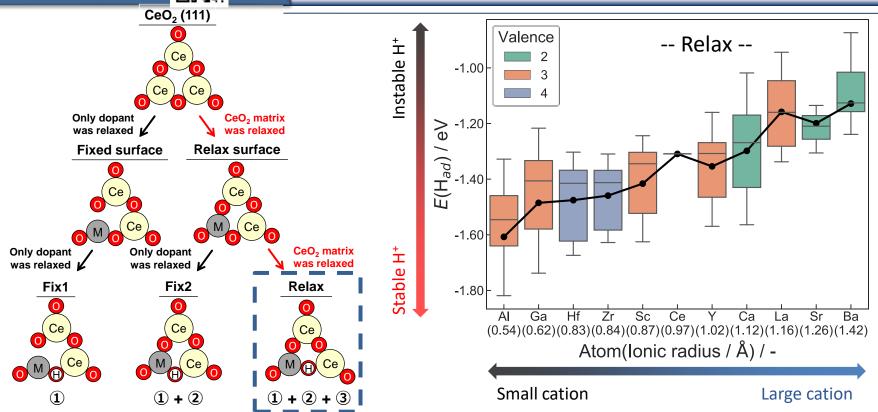


Catalyst /-	Ru particle size / nm
Ru/SrZrO₃	6.8
$Ru/SrZr_{0.875}AI_{0.125}O_{3-\delta}$	7.6
$Ru/SrZr_{0.875}Y_{0.125}O_{3-\delta}$	6.0
Ru/Sr _{0.875} Ca _{0.125} O ₃	6.7
Ru/Sr _{0.875} Ba _{0.125} O ₃	6.6

- Ba, Ca addition enhanced NH₃ synthesis rate in the electric field
- Ru particle size was almost constant among all catalysts
 - These supports can be used for the comparison of intrinsic activities

 \rightarrow

Relaxの結果



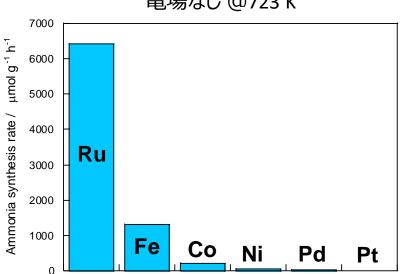
- Dopant ionic radius evidently governed the adsorption energies
 - → Smaller cation doping produces various relaxation patterns that make the adsorption of H atoms favorable
 - Smaller cation doping strengthened the H atom adsorption thanks to the facilitation of lattice distortion



各種担持金属におけるアンモニア合成活性の比較

電場印加時の活性金属の序列を明らかにする





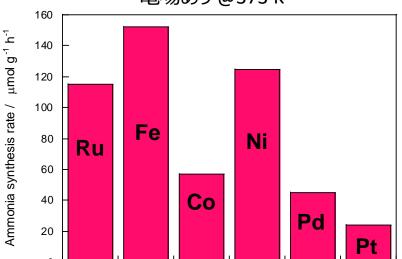
触媒:7wt%Metal/CeO2 (Metal: Fe, Ru, Pd, Pt, Ni, Co)

触媒量:100 mg

前処理: N₂/H₂=60/180 SCCM, 700℃, 0.5h保持

印加電流值: 0,6 mA

電場あり@373 K



- 熱のみの場合は従来の報告と同様の傾向を示した(Ru>Fe>Co>Ni>Pd=Pt=0)
- 電場を印加することによって上記序列が大きく変化(Fe>Ni>Ru>Co>Pd>Pt)

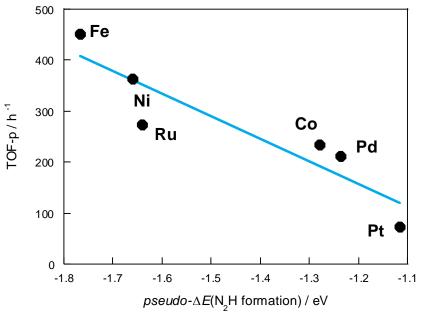


- 電場印加時には通常の触媒反応とは異なる因子が活性を決めている可能性
- Ruよりも非常に安価なFe系触媒を用いて高い性能が出せる可能性



電場アンモニア合成活性を決める因子

目的:活性金属の序列を決める因子を検討



触媒: 7wt%Metal/CeO₂ (Metal: Fe, Ru, Pd, Pt, Ni, Co)

触媒量:100 mg

前処理: N₂/H₂=60/180 SCCM, 700℃, 0.5h保持

印加電流值:6 mA

psuedo- $\Delta E(N_2H \text{ formation}) = \Delta E(N_2H \text{ adsorption}) - \Delta E(N_2 \text{ adsorption})$

- 各金属のTOF-pをpsuedo-∆E(N₂H formation)に対してプロット
- 線形に近い関係が確認された



● 電場印加時にはN2Hの生成エネルギーがアンモニア合成活性を左右する

$$H_2 \rightarrow 2H_{ad}$$
 (1)

$$H_{ad} \rightarrow H^+ + e^- \tag{2}$$

$$N_2 + H^+ \rightarrow N_2 H^+ \tag{3}$$

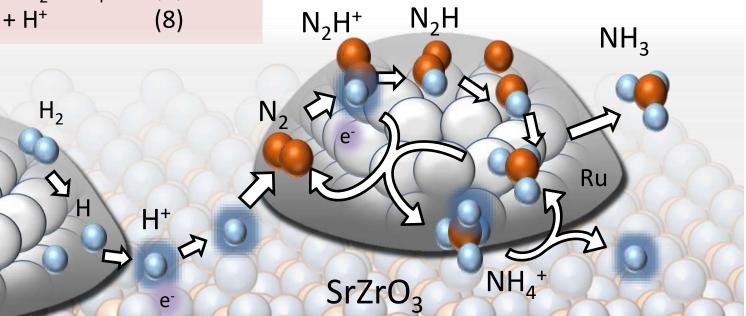
$$N_2H^+ + e^- \rightarrow N_2H \tag{4}$$

$$N_2H \rightarrow NH + H$$
 (5)

$$N_{ad} + 3H_{ad} \rightarrow NH_3 \tag{6}$$

$$N_2H^+ + NH_3 \rightarrow N_2 + NH_4^+$$
 (7)

$$NH_4^+ \rightarrow NH_3 + H^+ \tag{8}$$





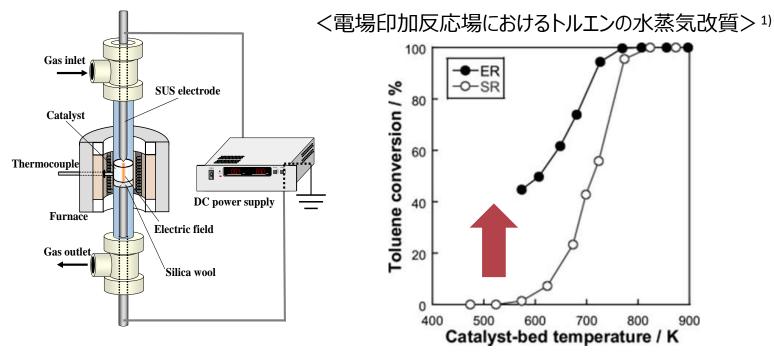
- ➤ 電場アンモニア合成におけるRu系触媒の高性能化、 非貴金属系触媒の開発、電場中での触媒反応の学理解明
- ➤ Ru系触媒→得られた知見を日本触媒さまが展開中
- ▶ 非貴金属系触媒→鉄やコバルトが活性を発現しうることを発見
- ▶ 学理解明については、電子・イオン伝導パスについて交流インピーダンス法と直流伝導評価の組み合わせ手法を確立



- ▶ 非在来型触媒プロセスとしての表面プロトニクス
 - ▶ 電場印加表面プロトニクスによる低温触媒プロセス
 - > 二酸化炭素再資源化
 - > アンモニア合成
 - ▶ 電場を印加した低温排気ガス浄化触媒プロセス



電場を印加した触媒プロセスについて

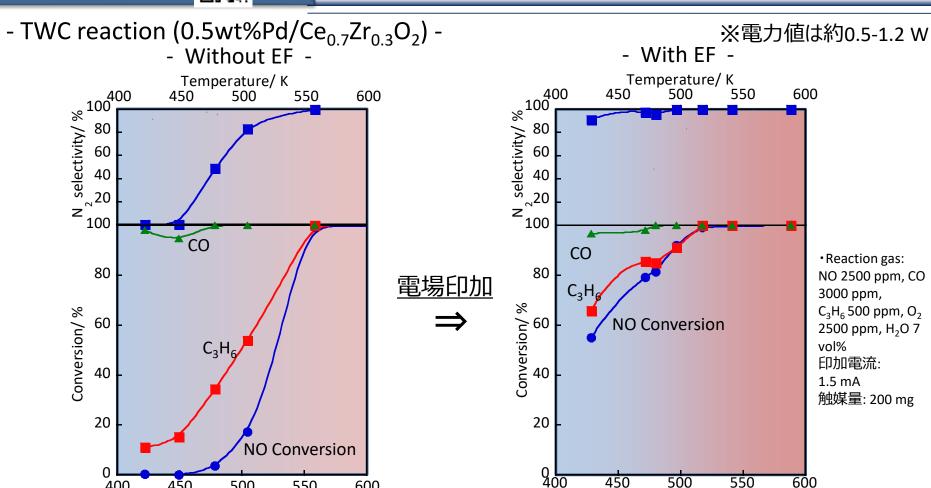


- 触媒層上下に電極を接触させ、直流電流を印加する事で電場を形成
- 電場を印加する事により、表面プロトニクスによりSRやアンモニア合成など様々な反応系において低温で高い活性を示す
- 電場触媒反応を用いた各種反応において、電場の印加により低温でも高い格子酸素放出能を示すことも見出してきた(ペロブスカイト担体などを利用)

三元触媒系に電場を与えて表面イオニクスを活かした低温反応を実現する



電場を印加した三元活性評価



- 電場を印加する事で低温域(423~473 K)におけるNO, C3H6の転化活性が向上
- 低温域から高温域にかけて, 電場を印加すると高いN₂選択率を示す

600

550

400

450

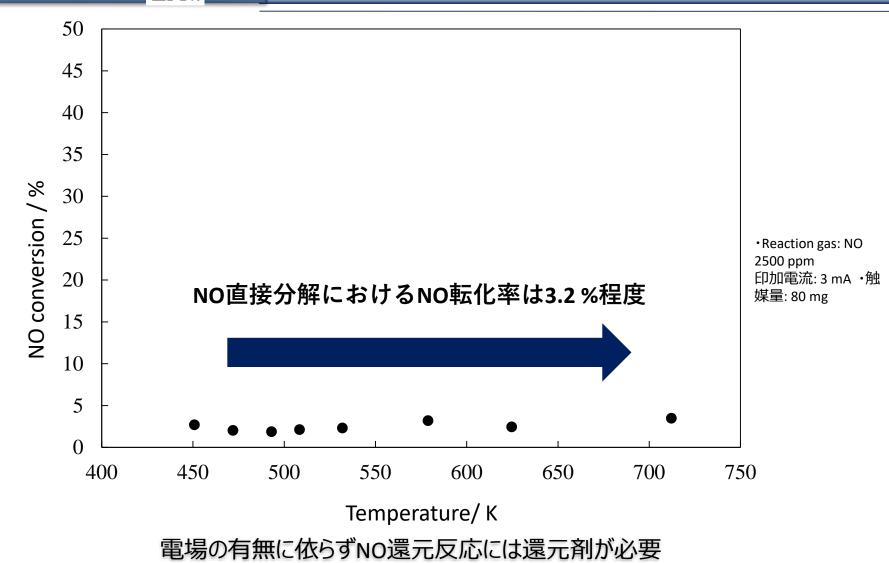
500

Temprature/ K

Temprature/K

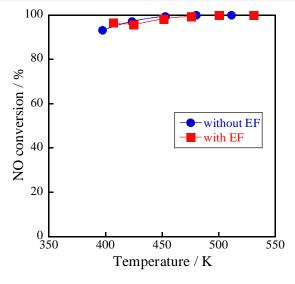


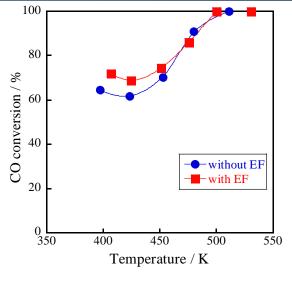
NO直接分解反応の検討





NO-CO-O₂-H₂O雰囲気





100

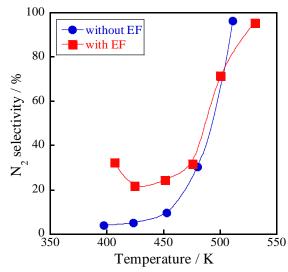
80

60

40



- · Reaction gas: NO 2500 ppm, CO 3000 ppm, O₂ 250 ppm, H₂O 7 vol% ·印加電流: 3 mA ·触媒量: 80 mg
- ✔ 低温域で高いNO転化率 (電場の有無に依らず) →酸素量がかなり少な く実質NO-COのみの反応 になっている可能性
- ✔ N₂選択率は電場による向 上は見られるものの低温 域では40%以下
- 酸素転化率は全温度域で 電場の有無に依らず 100 %

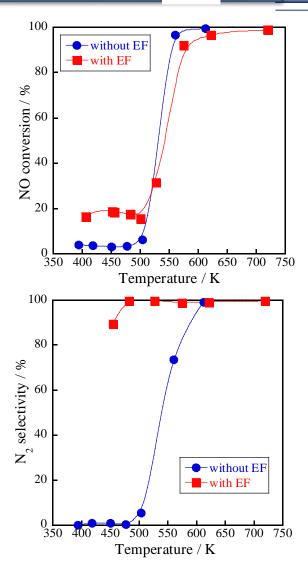


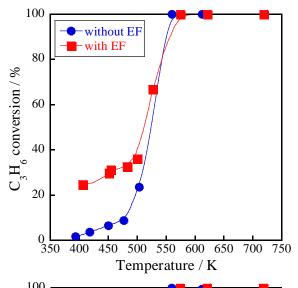
with EF

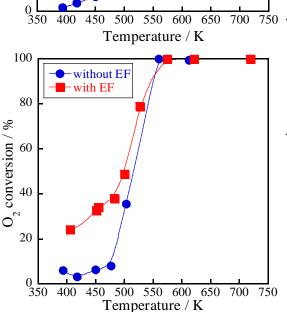
without EF

NO-C₃H₆-O₂-H₂O 雰囲気









- •Reaction gas:
 NO 2500 ppm, C₃H₆ 500 ppm,
 O₂ 1000 ppm, H₂O 7 vol%
 •印加電流: 3 mA •触媒量: 80 mg
- ✓ 電場印加でNO, C₃H₆転 化率が向上
- ✓ N₂選択率は電場印加 で100%
- ✓ 酸素の消費はC₃H₆の転化トレンドに類似



NO-CO, NO-C3H6条件と TWC条件の比較

成分分離試験まとめデータ

	NO conversion(N ₂ selectivity)/ %						
	Without EF 420 K	Without EF 475 K	Without EF 500 K	With EF 420 K	With EF 475 K	With EF 500 K	
NO-CO-O ₂ -H ₂ O	97.2(5.2)	100(30.4)	100(96.2)	95.8(22.9)	99.5(32.0)	100(71.7)	
$NO-C_3H_6-O_2-H_2O$	3.6(0.846)	3.4(0.294)	6.2(5.4)	14.4(92.4)	13.7(100.0)	17.7(100.0)	
TWC condition	0.11(0.0)	0.27(0.0)	3.5(13.4)	13.7(100.0)	14.4(100.0)	23.0(100.0)	

NO-CO条件

- 電場の有無によるNO転化率の差は殆どなし
- 低温域の電場印加時のN₂選択率は20~30 %程度

NO-C₃H₆条件

- 低温域で電場印加によりNO転化率が向上
- 全温度域でN₂選択率はほぼ100 % ⇒ TWC条件下のトレンドと一致





In-situ IRによる反応中間体の観測

5% O₂ 15 min @773, 573 K(EF)

5% H₂ 15 min @773, 573 K(EF)





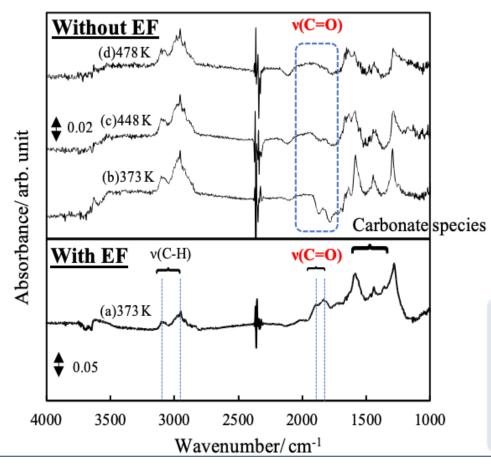
1281, 1594 cm⁻¹: Carbonate species

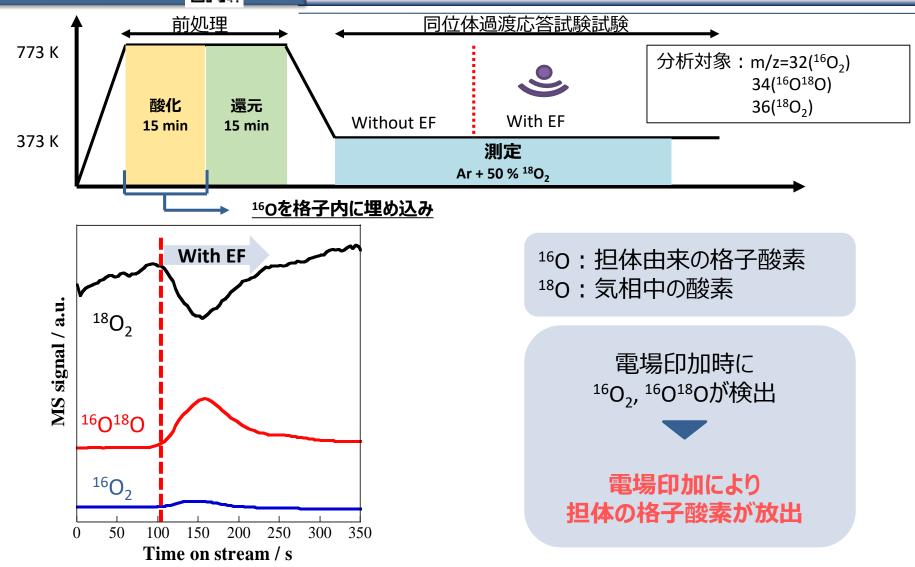
1841, 1908 cm⁻¹: Carbonyl species (C=O)

2984, 3101 cm⁻¹: v(C-H)

- ・電場印加時(スペクトル(a))にカルボニル由来の C=Oの結合ピークが観察
- 100~200℃の温度域において,電場非印加時にカルボニル由来のC=Oピークは観察されない
- ・本測定にて反応ガスに酸素は含まず,酸素源は 担体格子酸素のみ
- ✓ 電場印加時にのみC₃H₆の部分酸化反応が進行
- ✓ 電場印加により担体格子酸素の放出が促進され C₃H₅の部分酸化反応が進行

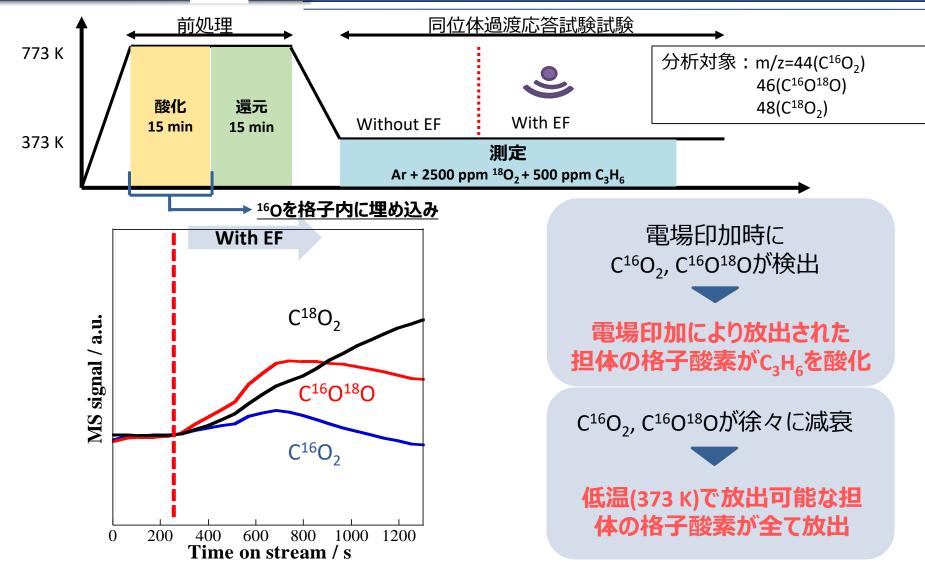
低温域で高いNO還元活性を示す







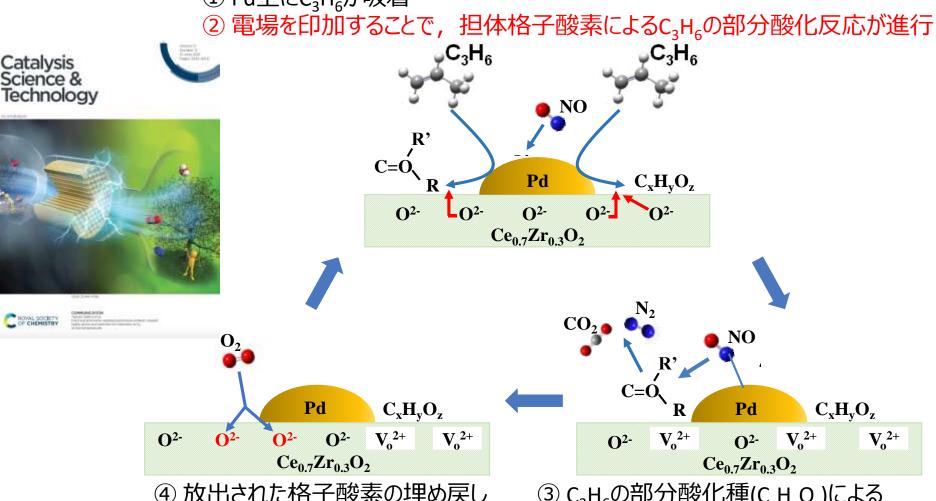
18O2によるC3H6酸化試験





想定されるNO還元反応スキーム

① Pd上にC3H6が吸着



④ 放出された格子酸素の埋め戻し

③ C₃H₆の部分酸化種(C_xH_vO_z)による NO還元反応が進行



- 電場を印加する事で低温域のNO, C3H6浄化活性が向上
- 電場印加時の低温域におけるNO還元反応はC₃H₆による還元が主反応
- coは電場印加の有無に関わらず酸素との反応により消費
- 電場印加時のNO-C₃H₆反応では、酸素を有効に用いる反応経路でNO-C₃H₆反応が進行
- 低温域において電場を印加する事で、担体格子酸素が放出され、C3H6の部分酸化反応を促進し、低温で高いNO還元活性を示す

非在来型の触媒反応として・・・

- ◆ 担体の特性を制御し、電位を印加し担持金属表層の 電子状態を変えることで、低温でも高性能な触媒反応 が可能に
- ◆ 担体の構造を高度に制御し、表面プロトニクスを活かした触媒によって、低温で高活性・低炭素析出・高安定性・高選択性を有する触媒を創出可能



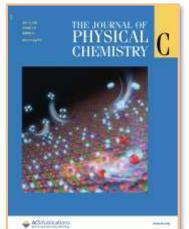
応用化学科 関根研究室

「「啼かぬなら啼かせてみよう」の化学を世界に先駆けて実現

関根研の最近の発見が英米の一流誌の表紙にて数多く紹介されています



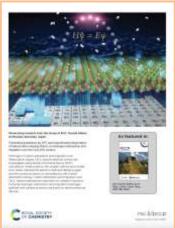
2020CC表紙 反アレニウス則の発見



2020JPC表紙 エチレン選択合成



2021CC表紙 表面プロトニクスの概念確立 計算化学で予言



2021PCCP表紙



2021CST表紙 低温で環境浄化



型に 関根研 ヴェブ

さきがけ総括として領域を紹介



クイックアクセス

[反応制御]電子やイオン等の能動的制御と反応

- **プレス発表**
- の お知らせ
- 篇 イベント
- パンフレット
- 本ページの目次
- 戦略目標
- ▶ 研究総括
- 概要
- 領域アドバイザー
- 採択課題一覧

戦略目標

持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出

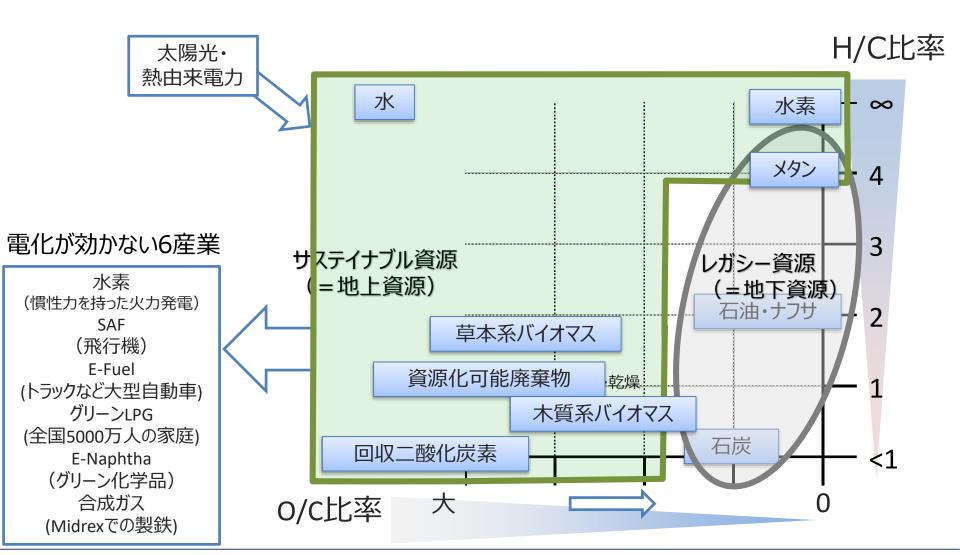
研究総括



関根 泰 (早稲田大学 理工学術院 教授)

◆ トップに戻る

地下資源の時代からようこそ地上資源の時代へ





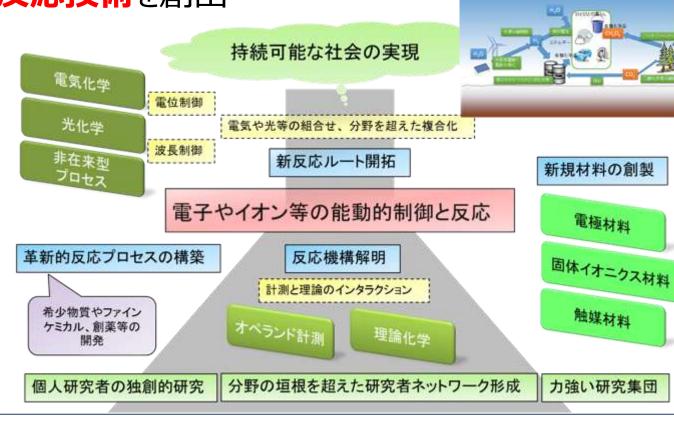
戦略目標:持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出

電気や光などを用いて電子やイオンを能動的に制御し、

革新的な化学反応技術を創出

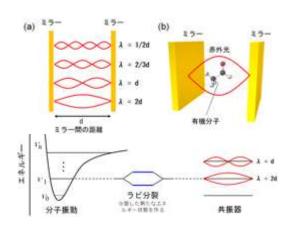
分野としては、

- ・<mark>化学</mark> 電気化学や光化学等
- ・<mark>反応プロセス</mark> フローリアクター等
- ・新規材料 電極材料、触媒材料 固体イオニクス材料等
- 計測(オペランド)
- •理論化学(計算)
- ・これらの融合
- ・従来技術の延長でないこと
- ・各自の持つシーズをもとに独創性のあること

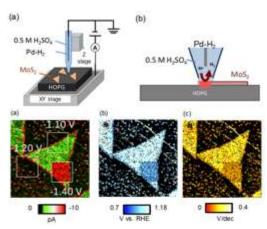




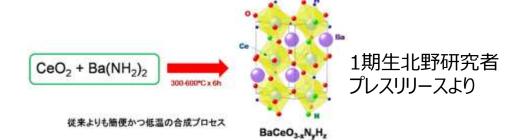
さきがけ 反応の能動的制御 成果

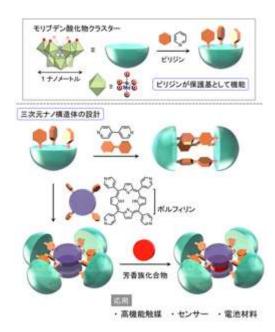


1期生平井研究者プレスリリースより



1期生高橋研究者プレスリリースより





1期生鈴木研究者プレスリリースより